

Atomic Layer Process (ALP) Workshop

日時：2016年3月4日（金） 午後1時 - 6時

場所：大阪大学東京オフィス 多目的室1・2

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階

<http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/facilities/tokyo/office>

(席数に限りがありますので、ご参加希望の方は、事前にご連絡ください。)

会議主旨：Atomic Layer Etching および Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition 技術の基礎を理解し、ガス・材料・プラズマ等の幅広い分野の研究者・技術者が同技術の問題意識を共有することにより、この分野の更なる技術革新を推進することを目的とする。

プログラム概要

13:00-13:20 浜口智志（阪大）： 開会のご挨拶：趣旨説明
1 13:20-14:00 霜垣幸浩（東大）：ALDプロセスの理想と現実ーラジカルは如何に有効か
2 14:00-14:40 田中基裕（日立ハイテク）：ALE装置開発の最前線 - 量産適用に向けたチャレンジ
3 14:40 - 15:20 野尻一男（ラムリサーチ）：Atomic Layer Etching for Conductor and Dielectric
break 15:20-15:40
4 15:40-16:20 辻 晃弘（TEL）：Quasi-ALE技術の微細 SAC 構造への適用と今後の展望
5 16:20-17:00 大村光広（東芝）：Layer by layer etching of LaAlSiOx
6 17:00 - 17:50 総合討論 司会：浜口智志（阪大）
17:50-18:00 浜口智志（阪大）： 閉会のご挨拶
18:30-20:30 懇親会 ビヤホールライオン 銀座七丁目店 東京都中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル 1F